



FACULTY OF PHYSICS AND MATHEMATICS



NAME: Gurbanov Muzaffar Qadamboyevich

POSITION: docent

TEL: +99897 512 95 49

E – mail: <u>muzaffarqq@mail.ru</u>

ORGANISATION TEL: +99862 2246700

ORGANISATION ADRESS: Urgench, Kh.Olimjan str, 14, 220100

EDUCATION:	Higher, 1999, UrSU, Faculty of Physics and Mathematics
CAREER / EMPLOYMENT:	1999 - 2001 - Laboratory assistant of the physics department of UrSU; 2001 - 2002 - Student of UrSU at the Department of Physics; 2002 - 2005 - Postgraduate student of the physics department of UrSU; 2005 - 2013 - Teacher of the Department of Physics, UrSU; From 2013 to present - Associate Professor of Physics, UrSU.
SPECIALITY	Electromagnetism, radio electronics.
TEACHING SUBJECTS:	Распыление кристалла LiF при облучении моно–и полиатомными ионами Ar^+ и SF_5^+
RESEARCH AREAS OF INTEREST:	1. Распыление кристалла LiF при облучении моно—и полиатомными ионами Ar⁺ и SF₅⁺ 2. Травление поверхности карбида кремния при бомбардировке молекулярными ионами SF₅⁺ (n=1÷5) 3. Исследование распыления и топографии поверхности монокристалла LiF(100) при бомбардировке полиатомными ионами SF₅⁺ 4. Исследование распыления и топографии поверхности монокристалла SiC при бомбардировке моно Ar⁺ и полиатомными SF₅⁺ ионами 5. Физическое и химически-стимулированное распыление 3C-SiC при бомбардировке ионами Ar⁺ и полиатомными ионами SF₅⁺ 6. Распыление кристалла LiF при облучении моно-и полиатомными ионами Ar⁺ и SF₅⁺ 7. Эмиссия атомарных и молекулярных ионов из LiF от энергии и скорости бомбардирующих ионов Ar⁺ и SF₅⁺ 8. Распыление монокристалла LiF при бомбардировке полиатомными ионами SF₅⁺ (n=1÷5) 9. Эмиссия атомарных и молекулярных ионов из кристалла LiF при облучении моно Ar⁺ и полиатомными SF₅⁺ (n=1÷5) 10. Сверхвысоковакуумный вторично-ионный масс-спектрометр для изучения травления и структуры поверхности полупроводников и диэлектриков при облучении электронами, моно и полиатомными ионами 11. Распыление кремния и карбида кремния при бомбардировке моно Ar⁺ и полиатомными ионами SF₅⁺ 12. Исследование распыления и топографии поверхности монокристалла LiF(100) при бомбардировке полиатомными ионами SF₅⁺ (n=1÷5) 13. Распыление кремния и карбида кремния при бомбардировке моно Ar⁺ и

полиатомными ионами SF_5^+

- 14. Распыление поверхности карбида кремния при бомбардировке молекулярными ионами SF_5^+
- 15. Распыление поверхности кремния и карбида кремния при бомбардировке молекулярными ионами $SF_n^+(n=1\div 5)$
- 16. Физическое и химическое распыление карбида кремния при бомбардировке моно ${\rm Ar^{\scriptscriptstyle +}}$ и полиатомными ионами ${\rm SF_5^{\scriptscriptstyle +}}$
- 17. Анализ фторированной поверхности карбида кремния методом электронностимулированной десорбции
- 18. Исследование распыления и топографии поверхности монокристалла SiC при бомбардировке моно Ar^+ и полиатомными SF_5^+ ионами
- 19. Исследование распыления и топографии поверхности монокристалла LiF(100) при бомбардировке моно ${\rm Ar}^{\scriptscriptstyle +}$ и полиатомными ионами ${\rm SF_5}^{\scriptscriptstyle +}$
- 20. Исследование стимулированного разрывом связей молекулярного распыления и травления поверхности пленки 3C-SiC при бомбардировке моно ${\rm Ar^+}$ и полиатомными ${\rm SF_5^+}$ ионами
- 21. Кинетика точечных дефектов и их агрегатов на поверхности пленки LiF/Si(111)
- 22. Изучение отрицательно-ионных кластеров SiC при бомбардировке ионами Cs+
- 1. Распыления кристаллов при бомбардировке моно- и полиатомными ионам
- 2. Kinetics of aggregations F2, F3, X and colloid centers in thin film LiF/Si(111) at low temperature annealing
- 3. Исследование рассеяния ионов со ступенчатой поверхности двухкомпонентных монокристаллов
- 4. Температурный эффект атомарного и кластерного распыления SiC(100), GaN и LiF(100) при облучении ионами Cs^+ и SF_5^+
- 5. Регистрация дефектов в спектрах ВИМС при отрицательно-ионном распылении кристаллов LiF
- 6. Молекулярное распыление из кристалла LiF при бомбардировке полиатомными ионами SF_n^+ (n=1-5)
- 7. Изучение массового состава положительно распыленных частиц из кристалла LiF при облучении ионами ${\rm Ar}^+$
- 8. Отрицательно-ионное распыление Al₂O₃
- 9. Распыления тонких плёнок, покрытой на поверхность $\mathrm{Au}(111)$ при бомбардировке ионами $\mathrm{Ar}^{\scriptscriptstyle +}$
- 10. Распыления тонких плёнок, покрытой на поверхность Au(111) при бомбардировке ионами Ar^+
- 11. Mechanism of Aggregation Colloid Centers on Surface Ionic Crystals
- 12. Procedure for Determining Defects in Sputtered Clusters of Ionic Crystals
- 13. Изучения закономерности рассеяния ионов Ar^+ и Ne^+ с поверхности кластера кремния
- 14. Температурные зависимости распыления поверхности Si (111) при облучении ионами Cs
- 15. Влияние низкоэнергетических электронов на поверхность кристаллов оксида пинка
- 16. Электронно-спектрометрический контроль процесса очистки кремниевых пластин
- 17. Angular and energy distributions of low-energy argon ions at the scattering from A^{III}B^V semiconductor surface
- 18. Исследование малоугловое рассеяния ионов с поверхностью InP(001)
- 19. Изучение характерных траектории рассеяных ионов с поверхностью InP(001) при бомбардировке ионами Ar^+ и Ne^+
- 20. Закономерности рассеяния ионов с поверхностью InP(001) при малых углах скольжениях
- 21. Рассеяния ионов с дефектной поверхностью InP(001) при малых углах скольжениях
- 22. LiF кристалини якка ва кўпатомли ионлар таъсирида чанглатиш

PRESENT PROJECTS: